

西丽蓝牙芯片回收 西丽蓝牙IC收购公司

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 西丽蓝牙芯片回收 西丽蓝牙IC收购公司 |
| 公司名称 | 深圳市铭盛电子科技有限公司 |
| 价格 | 168.00/pcs |
| 规格参数 | 品牌:铭盛电子回收合作 型号:不限 产地:进口 |
| 公司地址 | 深圳市福田区中航路国利大厦 |
| 联系电话 | 0755-83292099 13534023459 |

产品详情

光耦合器的技术参数主要

有@@铭盛电子回收公司@@发光二极管正向压降VF

、[正向电流](#)IF、电流传输比CTR、输入级与输出级之间的绝缘电阻@西丽蓝牙芯片回收 西丽蓝牙IC收购公司@、集电极-发射极反向击穿电压V(BR)CEO、集电极-发射极饱和压降VCE(sat)。此外，在传输数字信号时还需考虑上升时间、下降时间、延迟时间和存储时间等参数。

电流传输比

是光耦合器的重要参数，通常用直流电流传输比来表示。当输出电压保持恒定时，它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。

使用光电耦合器主要是为了提供输入电路和输出电路间的隔离，在设计电路时，必须遵循下列原则：所选用的光电耦合器件必须符合国内和有关的有关隔离击穿电压的标准；由英国埃索柯姆（Isocom）公司、美国FAIRCHILD生产的4N××系列（如4N25、4N26、4N35）光耦合器，在国内应用地十分普遍。可以用于[单片机](#)的输出隔离；所选用的光耦器件必须具有较高的[耦合系数](#)。

以下为光电耦合器的常用参数：

反向电流IR：在被测管两端加规定反向工作电压VR时，二极管中流过的电流。

反向击穿电压VBR：被测管通过的反向电流IR为规定值时，在两极间所产生的电压降。

正向压降VF：二极管通过的正向电流为规定值时，正负极之间所产生的电压降。

正向电流IF：在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。结电容CJ：在规定偏压下，被测管两端的电容值。

反向击穿电压 $V_{(BR)CEO}$ ：发光二极管开路，集电极电流 I_C 为规定值，集电极与发射集间的电压降。